«Источники излучения для следующего поколения ВУФ литографии»

## К.Кошелев Институт спектроскопии РАН



## IC & Lithography roadmap



### NXE:3100 is the 1<sup>st</sup> generation of the NXE platform



- NA=0.25
- Sigma=0.8
- Resolution 27 nm
- SMO=4.5 nm
- MMO=7.0 nm
- Productivity
  60wph at
  10mJ/cm<sup>2</sup> resist



## Требования к источнику EUV

•Длина волны •Мощность (в 2% спер •Частота повторения •Размер источника	ктр.полосе)	13.5 [nm] >180 [вт] (до 500 вт) до 50 кГц не превышает 1 мм <sup>3</sup>
•Integrated Energy Stability ±0.3%, Зо за 50 импульсов		
collector lifetime to 10% reflection loss ≥ 30,000 часов reflection loss)		
130-400 [nm] (E IR	OUV/UV)	≤ 7% TBD

### В настоящее время рассматриваются два основных способа создания ЭУФ источников для промышленной проекционной литографии:

Плазма, создаваемая при фокусировке лазерного излучения на мишень Плазма электрических разрядов (Z – пинч)



### Прогресс в увеличении EUV мощности ксеноновых источников



\* - HVM – High Volume Production







Плазма, создаваемая при фокусировке лазерного излучения на мишень



Выбор лазерной системы для нагрева плазмы и генерации EUV излучения определяется, в частности, эффективностью процесса переноса энергии из области поглощения лазерной энергии в область, из которой EUV фотоны покидают плазму

### Комплекс программ для численного моделирования RZLINE – THERMOS - BELINE (R-T-B)





#### Коэффициент преобразования излучения СО2 лазера в EUV фотоны в узкой спектральной полосе 2 % для плоской мишени.



Плоская мишень не рассматривалась в практическом смысле из-за трудностей сбора излучения (обскурация) и высоких тепловых нагрузок и большого количества разбрызгиваемого олова.

#### Капельная мишень – mass limited approach.



Коэффициент преобразования для капельной мишени оказался очень маленьким (0,5 – 1 %). Причины: 1) сильное отражение ИК; 2) малый размер мишени по сравнению с размером каустики лазерного пучка.

Большое отражение ИК может быть фатальным для литографического процесса



### Идеальная мишень (I)

•Облако паров олова с плотностью вблизи/ ниже «критической» чтобы избежать отражения ИК излучения.

 размер – несколько сотен микрометров – соответствует требованиям оптической системы и достаточен для полного поглощения лазерного излучения

Ожидается высокий СЕ; Низкий уровень рассеянного ИК; «правильный» размер;

 очень короткое время жизни – при скорости разлета плазмы 5е6 cm/s и характерном размере D = 3е-2 cm – время жизни – несколько наносекунд

### Идеальная мишень – распределенная мишень



Состоит из большого числа микрокапель с размером 1 – 3 мкм, которые постепенно испаряясь поддерживают существование плазменной мишени в течении всего лазерного импульса.





Плазма, создаваемая при фокусировке лазерного излучения на мишень

\*Большие надежды, напряженная работа сотен (если не тысяч) людей;

•Остаются проблемы с рассеянным (отраженным) ИК излучением

•Еще один порядок по мощности EUV

### Разрядная плазма, как источник EUV излучения



### Развитие «микропинчей» в режиме радиационного сжатия

В аксиально-симметричных разрядах с энергией 1 – 10 Дж излучение EUV происходит в момент развития перетяжечной неустойчивости в столбе разряда.



#### Развитие микропинчей в режиме радиационного сжатия

Наблюдение образования перетяжек – микропинчей в аксиально – симметричном разряде в парах олова.

А – анод: С – катод:

верхнее изображение – VUV (1 – 100 nm)

Нижнее изображение – EUV (10 – 20 nm) – Zr/Si фильтр

Время экспозиции – 10 нсек: время между кадрами – 10 нсек.



#### Развитие микропинчей в режиме радиационного сжатия

## «Устойчивый» характер сценария развития перетяжечной неустойчивости



K4 **\**−830mB

Разрядная плазма, как источник EUV излучения

### Проблема : перегрев электродов

Решение – «мультиплицирование» разряда

## МУЛЬТИПЛИЦИРОВАНИЕ ИСТОЧНИКА (I)



### 2004

### Achieved:

• 2 % CE

• 18 kW (Continuous) 360 W in 2p in-band (about 36 W IF)



## МУЛЬТИПЛИЦИРОВАНИЕ ИСТОЧНИКА (II)



Ванна с жидким оловом

Разрядная плазма, как источник EUV излучения

Реализованы схемы с «колесными» электродами, получены мощности, превышающие те, что достигнуты в «лазерных» схемах...

Ожидаются принципиальные ограничения в величине вкладываемых мощностей (не более 100 кВт), связанные с конечной допустимой скоростью вращения «колёс»электродов в жидком олове.

## Разряд с использованием быстрых струй жидкого олова в качестве электродов



Скорость струй может достигать десятком метров в секунду, что позволяет поднять тепловую нагрузку до 200 - 250 кВт.









## (Мотивации):

- Разрешение повышается вдвое:  $\delta x \approx 8$  нм !!!
- Для формирования и управления излучением оптимальны многослойные интерференционные зеркала на основе <u>La/B</u>.

**R**<sub>max</sub>(La/B)=80%

 Возможно ли создание мощных источников излучения ?

## **Δn=0** переходы в трёх изоэлектронных последовательностях для различных атомов



### 4-4 переходы в Тb и Gd



# Спектр Gd плазмы при возбуждении излучением CO2 лазера



Typical spectrum of CO<sub>2</sub> laser produced Gd plasma

Plasma is optically transparent

CE increases with laser power density on the target

CE measured at 3.10<sup>10</sup> W/cm<sup>2</sup> is about 1% as maximum

Strong reflection of laser radiation is observed and it increase with increasing of laser power density

Absorption coefficient decreases with temperature

$$k_{abs}^{las} = \frac{16\pi Z n_e^2 e^6 \ln \Lambda(\nu)}{3c \nu^2 (2\pi m_e k_B T_e)^{3/2} (1 - \nu_p^2/\nu^2)^{1/2}}$$

# Измерение СЕ для плазмы Gd при возбуждении CO2 лазером



defined number of laser shots

Проблемы изготовления многослойной оптики на основе La/B(B<sub>4</sub>C)



Чрезвычайно низкая скорость распыления мишени бора при магнетронном распылении. Поэтому произошла замена чистого бора на его карбиды (**B**<sub>4</sub>**C**, **B**<sub>9</sub>**C**).

> $R_{max}(La/B_4C) = 70\%$ d=3.4 нм,  $\theta = 90^0$

Реально получен коэффициент отражения La/B<sub>4</sub>C - зеркал нормального падения: **45%**-47%.

Пути повышения отражательной способности La/B(B<sub>4</sub>C) зеркал



- Использование альтернативных методов напыления многослойных структур (распыление ионными пучками, распыление неоном)
- Ионное ассистирование (взаимодействие ионов инертного газа с плазмой конденсата, налетающего на подложку)
- Ионная полировка (травление каждой границы раздела слоев низкоэнергетичными ионами)
- Азотирование (образование на границах La/N и B/N)

С целью реализации возможности управления шириной границ раздела слоев в многослойных структурах изготовлен специальный технологический стенд, в котором сочетаются возможности нанесения МС методами



магнетронного распыления (включает четыре магнетронных источника) • ионного распыления (включает два ионных источника) ионной полировки каждой границы раздела слоев (два источника низкоэнергетичных ионов).

Это была история о том, как результаты фундаментальных исследований оказались ключевыми для развития одной из наиболее важных технологий сегодняшней цивилизации

#### Мы благодарны научным коллективам ФИАН, МГУ, ИПМ.... которые принимали и продолжают принимать участие в Проекте.

Благодарю за внимание!